PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-241442

(43) Date of publication of application: 28.08.2002

(51)Int.CI.

C08F220/26 C08F222/06 C08F232/00 C08K 5/00 C08L 33/14 C08L 35/00 C08L 45/00 // G03F 7/039

(21)Application number: 2001-043161

(22)Date of filing: 20.02.2001

(71)Applicant : DAICEL CHEM IND LTD

(72)Inventor: TSUTSUMI KIYOHARU

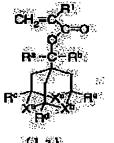
ITOKAZU TERUO

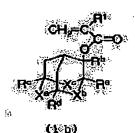
(54) POLYMER COMPOUND FOR PHOTORESIST AND RESIN COMPOSITION FOR PHOTORESIST

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin for photoresist capable of giving a fine pattern having high resolution excellent in homogeneity.

SOLUTION: In the resin for photoresist there is used a compound represented by general formulas (1a) and (1b) (wherein, R1 is a hydrogen atom or a methyl group; Ra and Rb are each a 1-8C hydrocarbon group which may be the same or different; Rc, Rd and Re are each a hydrogen atom or a methyl group which may be the same or different; Xa, Xb and Xc are each -CH2- or -CO-O- which may be the same or different, provided at least one of Xa, Xb and Xc is -CO-O-) as a monomer.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 寺開2002-241442

(P2002-241442A) (43)公開日 平成14年8月28日(2002.8.28)

4J100

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テーマコード (参考)
C08F220/26		C08F220/26	2H025
222/06		222/06	4J002

232/00 232/00 C08K 5/00 C08K 5/00 CO8L 33/14 CO8L 33/14

> 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全19頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-43161(P2001-43161) (71)出願人 000002901

ダイセル化学工業株式会社 (22)出願日 平成13年2月20日(2001.2.20) 大阪府堺市鉄砲町1番地

> 堤 聖晴 (72)発明者

> > 兵庫県姫路市網干区新在家940

(72)発明者 糸数 輝雄

するフォトレジスト樹脂を提供する。

埼玉県浦和市太田窪5-26-15

最終頁に続く

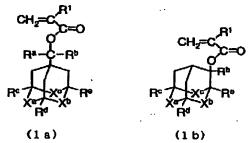
(54) 【発明の名称】フォトレジスト用高分子化合物及びフォトレジスト用樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】均質性に優れ、解像度の高い微細パターンを得 ることのできるフォトレジスト用樹脂を得る。

【解決手段】下記一般式(1a)及び(1b)

【化1】



(式中、R'は水素原子又はメチル基を示す。R'及びR ⁶は、同一又は異なって、炭素数1~8の炭化水素基を 示し、R'、R'及びR'は、同一又は異なって、水素原 子又はメチル基を示す。X'、X'及びX'は、同一又は 異なって、-CH.-、又は-CO-O-を示す。但 し、X'、X'及びX'のうち少なくとも1つは-CO-0-である。) で表される化合物をモノマーとして使用

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1a)及び(1b) 【化1】

(式中、R¹ は水素原子又はメチル基を示す。R¹ 及びR¹ は、同一又は異なって、炭素数 1 ~ 8 の炭化水素基を示し、R²、R² 及びR² は、同一又は異なって、水素原子又はメチル基を示す。X²、X³ 及びX² は、同一又は異なって、一CH₁ 一、又は一CO-O-を示す。但し、X²、X³ 及びX² のうち少なくとも 1 つは - CO-O-である。)で表される化合物。

【請求項2】 下記一般式 (Ia) 及び (Ib) 【化2】

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示す。 R^4 及び R^6 は、同一又は異なって、炭素数 $1\sim8$ の炭化水素基を示し、 R^4 、 R^4 及び R^6 は、同一又は異なって、水素原子又はメチル基を示す。 X^4 、 X^6 及び X^4 は、同一又は異なって、 X^4 、 X^6 及び X^4 のうち少なくとも 1 つは 1 この 1 つである。)で表されるモノマー単位から選択された

少なくとも 1 種のモノマー単位を含むフォトレジスト用

10 【請求項3】 前記高分子化合物が、式(Ia)及び(Ib)で表されるモノマー単位から選択された少なくとも1種のモノマー単位と、その他の(メタ)アクリル酸エステルから選択された少なくとも1種のモノマー単位からなる請求項2記載のフォトレジスト用高分子化合物。【請求項4】 前記高分子化合物が、式(Ia)及び(Ib)で表されるモノマー単位から選択された少なくとも1種のモノマー単位と、下記式(IIa)~(IIf)【化3】

20

髙分子化合物。

(式中、R¹は水素原子又はメチル基を示す。R¹、R³ 及びR'は、同一又は異なって、水素原子又はメチル基 を示し、 X'、X'及びX'は、同一又は異なって、-C H₁ - 、 - CO - 又は - CO - O - を示す。但し、X'、 X'及びX'のうち少なくとも1つは-CO-又は-CO -O-である。R'、R'及びR'は、同一又は異なっ て、水素原子、メチル基、ヒドロキシル基、カルボキシ ル基又は-COOR®を示す。R®は置換基を有してもよ いアルキル基、環状アルキル基、有橋環状アルキル基、 環状エーテル基、環状エステル基を示す。 R'及びR'® は、同一又は異なって、炭素数1~8の炭化水素基を示 し、 R''、R''及びR''は、同一又は異なって、水素 原子、メチル基又はヒドロキシル基を示す。 R''は、 メチル基又はエチル基を示し、 R''、R''及びR ¹⁷は、同一又は異なって、水素原子、メチル基又はヒド ロキシル基を示す。 R''、R''、R''、R''、R''、 R^{**}、R^{**}、R^{**}及びR^{**}は、同一又は異なって、水素 原子又はメチル基を示す。p、q、r及びsはそれぞれ 0又は1を示す。 R''は置換基を有してもよい、炭素 数1~20のアルキル基、環状アルキル基、有橋環状ア ルキル基、環状エーテル基、環状エステル基を示し、R 11はR17の置換基であり、水素原子、ヒドロキシル基、 ヒドロキシメチル基、カルボキシル基又は-COOR¹

のアルキル基、環状アルキル基、有橋環状アルキル基、 環状エーテル基、環状エステル基を示す。 R³⁰ は水素 原子、ヒドロキシル基、ヒドロキシメチル基、カルボキ 30 シル基又は-COOR³¹を示す。 R³¹ は置換基を有し てもよい、炭素数 1~20のアルキル基、環状アルキル 基、有橋環状アルキル基、環状エーテル基、環状エステ ル基を示す。) から選択された少なくとも1種のモノマ ー単位とを含む請求項2記載のフォトレジスト用高分子 化合物。

【請求項5】 Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値が9.5 (cal/cm³) $^{1/2}\sim 12.0$ (cal/cm³) $^{1/3}$ の範囲である請求項2、3又は4に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

40 【請求項6】 請求項2、3、4又は5の何れかの項に 記載のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤を少 なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物。

【請求項7】 請求項6記載のフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布してレジスト塗膜を形成し、露光及び現像を経てパターンを形成する工程を含む半導体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

ヒドロキシメチル基、カルボキシル基又は-COOR'' 【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工なを示し、R''は置換基を有してもよい、炭素数1~20 50 どを行う際に用いるフォトレジスト用の高分子化合物

と、この高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂 組成物、及び半導体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】フォトレジスト用樹脂の機能設計において、シリコンウエハなどの基板に対する密着性を付与する部分と、露光により光酸発生剤から発生する酸により脱離してアルカリ現像液に可溶になる部分が必要であり、またエッチングに対する耐性が必要である。特に、露光工程での光源として、現在エキシマレーザーのArFを使用し、ギガオーダーの半導体への期待は高まっている。しかし、ArFは遠紫外で193nmの波長であることから、レジスト材料も紫外線領域での透明性が要求され、新規なモノマーが提案されている。

【0003】側鎖にラクトン骨格を有するアクリレートが特開平9-90637号公報に提案されているが、このエステル基であるメバロニックラクトンには基盤密着性はあるが、単環構造のため耐エッチング性に欠ける。また、多環式の一部がラクトン構造のアクリレートモノマーが特開2000-122294号公報、特開2000-26446号公報に示されているが、基盤密着性、耐エッチング性は優れるものの、酸によりアルカリ可溶となる性質、つまり酸脱離性機能を持たない。これらの機能をすべて有するモノマーの合成は非常に困難を要するものではあるが、合成可能であれば、次世代の半導体製造に画期的な進歩を与える。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、酸脱離性を持ち、しかもラクトン環を含有する脂環式炭化水素を(メタ)アクリル酸エステル基とした新規なる重合性化合物を提供することであり、また、ラクト 30ン環を含有する脂環式炭化水素を(メタ)アクリル酸エステル基とした新規なる重合性化合物をモノマーとして、少なくとも1種合むことにより、プロックの生成を回避し、密着性に優れ、しかもエッチング耐性も高いフォトレジスト用高分子化合物を提供する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討の結果、重合による高分子化合物の製造においてプロックの生成を回避し、密着性に優れ、しかもエッチング耐性も高いフォトレジスト用高分子化合物を見出し、本発明を完成した。

【0006】すなわち、本発明は、下記一般式 (1a) 及び (1b)

[0007]

【化4】

露光工程での光源として、現在エキシマレーザーのArF を使用し、ギガオーダーの半導体への期待は高まってい 10 では R'及びR'は、同一又は異なって、炭素数 $1\sim 8$ の る。しかし、ArFは遠紫外で 193 nmの波長であることから、レジスト材料も紫外線領域での透明性が要求され、新規なモノマーが提案されている。 【0003】 側鎖にラクトン骨格を有するアクリレートが特開平 9-90637号公報に提案されているが、このエステル基であるメバロニックラクトンには基盤密着

[0009] また、本発明は、下記一般式 (Ia) 及び (Ib)

[0010]

【化5】

20

【0011】(式中、R'は水素原子又はメチル基を示す。R'及びR'は、同一又は異なって、炭素数1~8の炭化水素基を示し、R'、R'及びR'は、同一又は異なって、水素原子又はメチル基を示す。X'、X'及びX'は、同一又は異なって、-CH、-、又は-CO-O-を示す。但し、X'、X'及びX'のうち少なくとも1つは-CO-O-である。)で表されるモノマー単位から選択された少なくとも1種のモノマー単位を含むフォトレジスト用高分子化合物を提供することである。

【0012】さらに、本発明は、前記高分子化合物が、前記式(Ia)及び(Ib)で表されるモノマー単位から選択された少なくとも1種のモノマー単位と、その他の(メタ)アクリル酸エステルに由来する少なくとも1種のモノマー単位からなるフォトレジスト用高分子化合物を提供することである。

【0013】また、本発明は、前記高分子化合物が、式(la)及び(lb)で表されるモノマー単位から選択された少なくとも1種のモノマー単位と、下記式(lla)~(llf)

[0014]

50 【化6】

【0015】(式中、R'は水素原子又はメチル基を示 す。R'、R'及びR'は、同一又は異なって、水素原子 又はメチル基を示し、 X'、 X' 及び X' は、同一又は異 なって、- CH1 - 、- CO- (カルボニル基) 又は-CO-O-を示す。但し、X'、X'及びX'のうち少な くとも1つは-CO-又は-CO-O-である。R'、 R'及びR'は、同一又は異なって、水素原子、メチル 基、ヒドロキシル基、カルボキシル基又は-COOR を示す。R[®]は置換基を有してもよいアルキル基、環状 アルキル基、有橋環状アルキル基、環状エーテル基、環 状エステル基を示す。R'及びR'oは、同一又は異なっ て、炭素数1~8の炭化水素基を示し、 R''、R''及 びR¹³は、同一又は異なって、水素原子、メチル基又は ヒドロキシル基を示す。 R''は、メチル基又はエチル 基を示し、 R''、 R''及びR''は、同一又は異なっ て、水素原子、メチル基又はヒドロキシル基を示す。 R¹⁸、R¹⁹、R²⁰、R²¹、R²¹、R²³、R²⁴、R²⁴及び R¹⁶は、同一又は異なって、水素原子又はメチル基を示 す。p、q、r及びsはそれぞれ0又は1を示す。R 11は置換基を有してもよい、炭素数1~20のアルキル 基、環状アルキル基、有橋環状アルキル基、環状エーテ ル基、環状エステル基を示し、R'1はR'1の置換基であ り、水素原子、ヒドロキシル基、ヒドロキシメチル基、 カルボキシル基又は-COOR''を示し、R''は置換基 50 ル」と総称する場合がある。

を有してもよい、炭素数1~20のアルキル基、環状ア ルキル基、有橋環状アルキル基、環状エーテル基、環状 エステル基を示す。R30は水素原子、ヒドロキシル基、 30 ヒドロキシメチル基、カルボキシル基又は-COOR31 を示す。 R31 は置換基を有してもよい、炭素数1~2 0のアルキル基、環状アルキル基、有橋環状アルキル 基、環状エーテル基、環状エステル基を示す。)から選 択された少なくとも1種のモノマー単位とを含むフォト レジスト用高分子化合物を提供することである。

【0016】半発明は、またFedorsの方法による 溶解度パラメーターの値が9.5 (cal/cm) 1/1 ~12.0 (cal/cm³) 1/3 の範囲であるフォトレ ジスト用高分子化合物を提供することである。

【0017】また、本発明は、前記のフォトレジスト用 髙分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレジ スト用樹脂組成物を提供することである。

【0018】さらに、本発明は、前記したフォトレジス ト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布してレジスト塗 膜を形成し、露光及び現像を経てパターンを形成する工 程を含む半導体の製造方法を提供することにある。

【0019】なお、本明細書では、「アクリル」と「メ タクリル」とを「(メタ)アクリル」、「アクリロイ ル」と「メタクリロイル」とを「(メタ) アクリロイ

[0020]

【発明の実施の形態】本発明のフォトレジスト用高分子 化合物は、ポリマー分子を構成する構造単位として、前 記式(Ia)又は(Ib)から選択された少なくとも1 種のモノマー単位(繰り返し単位)(以下、「モノマー ユニット [] と称することがある) を含んでいる。この モノマーユニットIは、親水性の高いラクトン環を有し ているため、基板への密着性を高める密着性付与ユニッ トとして機能する。また、脂環式炭素環(シクロヘキサ ン環)をも有しているため、エッチング耐性を高める機 10 能をも有する。更に、(メタ)アクリロイル基に結合し たエステルは酸によりアルカリ可溶になるため、脱離性 機能も有することになる。

[式 (Ia) 及び (Ib) のモノマー単位] 式 (Ia) のモノマー単位に対応するモノマーは下記式 (1 a) で、式(Ib)のモノマー単位に対応するモノマーは下 記式 (1 b) で表される。なお、これらのモノマーにお いて異性体が存在する場合には、それらは単独で又は混 合物として使用できる。

[0021]

【化7】

【0022】(式中、R'は水素原子又はメチル基を示 す。 R'及びR'は、同一又は異なって、炭素数1~8の 炭化水素基を示し、R'、R'及びR'は、同一又は異な って、水素原子又はメチル基を示す。 X'、 X' 及びX' は、同一又は異なって、一CH、一又は一CO一O一を 示す。但し、X'、X'及びX'のうち少なくとも1つは -CO-O-である。)

式(1a)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

[1-1]1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー1 ーメチルエチル) -4-オキサトリシクロ[4.3. 1. 1^{3.1}] ウンデカン-5-オン(R¹=H又はC H_3 , $R^a = R^b = CH_3$, $R^c = R^d = R^c = H$, $X^a = -C$ $O - O - X_b = X_c = -CH_1 -$

[1-2]**1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー 1** -エチルプロピル) -4-オキサトリシクロ[4.3. 1. 1^{3.4}] ウンデカン-5-オン(R'=H又はC H_3 , $R^{\bullet} = R^{\bullet} = CH_1CH_3$, $R^{\circ} = R^{\bullet} = R^{\circ} = H_1X^{\bullet}$ $=-CO-O-, X^{b}=X^{c}=-CH, -)$ 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1 ーメチルプロピル) - 4 - オキサトリシクロ「4、3、 1. 1'.'] ウンデカン-5-オン(R'=H又はC H_3 , $R^a = CH_3$, $R^b = CH_1CH_3$, $R^c = R^d = R^c =$ $H, X' = -CO - O - X^b = X^c = -CH_1 - O$ [1-4] 1- (1- (メタ) アクリロイルオキシー 1, 2-ジメチルプロピル) -4-オキサトリシクロ [4. 3. 1. $1^{3.8}$] $\dot{0}$ 又は CH_1 、 $R^1 = CH_1$ 、 $R^5 = CH$ (CH_1), $R^c =$ $R^{e} = R^{e} = H, X^{e} = -CO - O - X^{b} = X^{e} = -CH_{1}$ -)

[1-5] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1-メチルエチル) - 4, 7 - ジオキサトリシクロ [4. 4. 1. 1^{3.1}] ドデカン-5, 8-ジオン (R'=H又 20 $\sharp CH_3$, $R^4 = R^6 = CH_3$, $R^c = R^6 = R^c = H$, X^4 $=X^{b}=-CO-O-, X^{c}=-CH, -)$ **1-(1-(メタ)アクリロイルオキシ-1** ーエチルプロピル) - 4, 7 - ジオキサトリシクロ [4.4.1.1³.¹] ドデカン-5,8-ジオン(R¹ $=HXICH_1$, $R^s=R^b=CH_1CH_1$, $R^c=R^d=R^c$ $=H, X' = X' = -CO - O - X' = -CH_1 - O$ 1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー1 ーメチルプロピル) -4,7-ジオキサトリシクロ [4.4.1.1^{3.1}] ドデカン-5,8-ジオン(R¹ $30 = HX \& CH_1$, $R^{\bullet} = CH_1$, $R^{\bullet} = CH_1$, $R^{\bullet} =$ $R^{4} = R^{c} = H$, $X^{a} = X^{b} = -CO - O -$, $X^{c} = -CH$, -)

[1-8]1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー 1,2-ジメチルプロピル)-4,7-ジオキサトリシ クロ[4.4.1.13.7] ドデカン-5,8-ジオン $(R^1 = H又はCH₃、 R^4 = CH₃、 R^6 = CH₃ (CH₃)$ $_{1}$, $R^{c} = R^{d} = R^{c} = H$, $X^{e} = X^{b} = -CO - O - CC$ $=-CH_1-$

前記式(1a)に示した化合物を製造する方法につい 40 て、以下に反応式をもって説明した。

[0023]

【化8】

エステル化工程

【0024】この反応式の中での各工程を以下に説明す

化合物D

テル化した後に、グリニヤール試薬を使用して、還元反 応することにより反応式記載のアルコールが得られる。 グリニヤール試薬としてメチルヨウ化マグネシウム (C H, MgI)を使用すると、R, R 共にメチル基のアル コール体が得られる。この合成については、Angew. Che m., Vol. 90. P998 (1978) に報告されている。

[酸化工程]N-ヒドロキシフタルイミドなどのイミド化 合物と、パナジウムなどの金属化合物の存在下、ガス状 の酸素により酸化して化合物Bより化合物Cが合成され る。同類の化合物の合成が特開平10-316601号 30 公報に報告されている。

【0025】[ラクトン化工程]化合物 Cのような環状ケ トン化合物は活性酸素を有した過酸化物によるバイヤー ビリガー反応で相応するラクトンが形成されることは周 知のことであり、本発明においても化合物Cは過酢酸に より収率良くラクトン骨格を有する化合物Dが得られ た。

[エステル化工程]化合物Dは分子内にヒドロキシル基を 有し、トリエチルアミンの存在下、メタクリルクロリド のような酸クロリドと反応し、相応するメタクリレート 40 -4, 7-ジオキサトリシクロ [4.4.1.11・1] 化合物Eが得られる。それぞれの具体的製造方法の例は 実施例の中の合成例にて示した。

【0026】式(1b)で表される化合物の代表的な例 として下記の化合物が挙げられる。

[1-9]2-(メタ) アクリロイルオキシ-2-メチ デカン-7-オン $(R'=H又はCH, R^b=CH, R$ $c = R^{4} = R^{c} = H$, $X^{a} = -CO - O - C$, $X^{b} = X^{c} = -C$

 $H_1 -)$

化合物E

[1-10] 2-(メタ) アクリロイルオキシ-2-エチ [グリニヤール還元工程]アダマンチルカルボン酸をエス 20 ルー6-オキサトリシクロ [4.3.1.13.4] ウン デカン-7-オン $(R^1 = H X \downarrow C H, R^2 = C H, C H)$ $R^c = R^d = R^c = H, X^e = -CO - O - X^b = X^c$ $=-CH_1-)$

> [1-11] 2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチル -4-オキサトリシクロ[4.3.1.1^{3.8}]ウンデ カン-5-オン $(R^1 = H X d C H, R^2 = C H, R^2)$ =R'=R'=H, X'=-CO-O-, X'=X'=-C

[1-12] 2-(メタ)アクリロイルオキシー2-エチル -4-オキサトリシクロ [4.3.1.1^{3.8}] ウンデ カン-5-オン (R^1 =H又はCH, R^b =CH, C H_1 , $R^c = R^d = R^c = H$, $X^b = -CO - O - X^c = X$ $'=-CH_1-)$

[1-13] 2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチル ドデカン-5, 8-ジオン (R'=H又はCH、R'= CH_{1} , $R^{c} = R^{d} = R^{c} = H$, $X^{a} = X^{b} = -CO - O - C$ $X^c = -CH_1 -$

[1-14] 2-(メタ) アクリロイルオキシー2-エチル ドデカン-5, 8-ジオン (R'=H又はCH, R'= $CH_{1}CH_{3}$, $R^{c}=R^{d}=R^{e}=H$, $X^{s}=X^{b}=-CO O - X^c = -CH_1 -$

前記式(1 b)に示した化合物を製造する方法につい て、以下に反応式をもって説明した。

[0.027]

【化9】

【0028】各工程とも、前記の化合物(1a)の工程 と同様にして製造される。それぞれの具体的製造方法の 例は実施例の中の合成例にて示した。

【0029】本発明の好ましい態様では、前記式(I) から選択された少なくとも1種のモノマー単位と、前記 20 CO-O-、 $X^i=X^i=-CH_i-$) 式 (IIa) ~ (IIi) から選択された少なくとも1種のモ ノマー単位(繰り返し単位)(以下、「モノマーユニッ ト川」と称することがある)とを含んでいる。

【0030】モノマーユニット川において、前記式(川 a)~(IIi)としての代表例を以下に示した。

[式 (IIa) のモノマー単位] 式 (IIa) のモノマー単 位に対応するモノマーは、下記式(2a)で表される。 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。

[0031]

【化10】

【0032】(式中、R'は水素原子又はメチル基を す。R'、R'及びR'は、同一又は異なって、水素原子 なって、一〇H・一、一〇〇一又は一〇〇一〇一を示 す。但し、X'、X'及びX'のうち少なくとも1つは-CO-又は-СО-О-である。)

式(2a)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

[2-1] 1-(メタ)アクリロイルオキシアダマンタ ンー4ーオン $(R^1 = H X \& C H_3, R^2 = R^3 = R^4 =$ $H, X^{i} = -CO -, X^{i} = X^{i} = -CH_{i} -)$

[2-2] 1-(メタ)アクリロイルオキシアダマンタ ン-4, 6-ジオン $(R^1 = H 又は C H_3, R^2 = R^3 = R 50)$ $'=H, X_1=X_2=-CO-, X_2=-CH, -)$

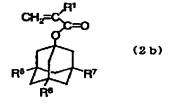
[2-3]1-(メタ)アクリロイルオキシー4-オキ サトリシクロ[4.3.1.13.1] ウンデカン-5-オン $(R^1 = H X は C H_1, R^2 = R^3 = R^4 = H, X^1 = -$

[2-4] 1-(メタ) アクリロイルオキシー4, 7-ジオキサトリシクロ [4.4.1.13.4] ドデカンー 5, 8-ジオン ($R^1 = H又はCH_1$ 、 $R^2 = R^3 = R^4 =$ $H, X^{1} = X^{2} = -CO - O - X^{3} = -CH_{1} - O$

[式(IIb)のモノマー単位]式(IIb)のモノマー単 位に対応するモノマーは、下記式(2b)で表される。 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。

[0033]

30 【化11】



【0034】(式中、R'は水素原子又はメチル基を示 す。 R'、R'及びR'は、同一又は異なって、水素原 子、メチル基、ヒドロキシル基、カルポキシル基又は一 又はメチル基を示し、 X'、X'及びX'は、同一又は異 40 COOR'を示し、R'は置換基を有してもよい、アルキ ル基、環状アルキル基、有橋環状アルキル基、環状エー テル基、環状エステル基を示す。)

> 式(2b)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

> [2-5]1-(メタ)アクリロイルオキシアダマンタ ン $(R^1 = H \times G \times G + R^2 = R^3 = H)$

> [2-6] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3、5-ジメチルアダマンタン $(R' = H \times CH_3, R' = R' =$ $CH_{3}, R'=H$

> [2-7]1-(メタ)アクリロイルオキシー3-ヒド

ロキシアダマンタン $(R' = H X は C H_1, R' = O H_2, R' = O H_3)$ $R^{4} = R^{7} = H$

[2-8]1-(メタ)アクリロイルオキシ-3,5-ジヒドロキシアダマンタン(R'=H又はCH,、R'= R' = OH, R' = H

[2-9]1-(メタ)アクリロイルオキシー3-カル ポキシアダマンタン $(R' = H \times LCH, R' = COO)$ $H, R^6 = R^7 = H$

[2-10] 1-(メタ)アクリロイルオキシー3,5-ジカルポキシアダマンタン (R'=H又はCH,、R'= 10 $R^{i} = COOH, R^{i} = H$

[2-11] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3-ヒド ロキシー5-カルポキシアダマンタン(R'=H又はC H_1 , $R^i = OH$, $R^i = COOH$, $R^i = H$)

[2-12] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3-t-プトキシカルポニルアダマンタン (R'=H又はCH₃、 $R^{i} = COOtBu, R^{i} = R^{i} = H$

[2-13] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3-(2 -テトラヒドロピラニルオキシカルボニル) アダマンタ $> (R^{I} = HX \& CH_{I}, R^{I} = COOTHP, R^{I} = R^{I})$ =H)

[2-14] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3、5-ジー t ープトキシカルポニルアダマンタン (R'=H又 $klCH_1$, $R^t = R^t = COOtBu$, $R^t = H$)

[2-15] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3.5-ジー (2ーテトラヒドロピラニルオキシカルポニル) ア ダマンタン (R'=H又はCH, R'=R'=COOTH P, R'=H

[2-16] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3-ヒド ロキシー5-t-プトキシカルボニルアダマンタン(R 30 -メチルプロピル)-3,5-ジメチルアダマンタン ¹=H又はCH₃、R¹=OH、R¹=COOtBu、R' =H)

[2-17] 1-(メタ)アクリロイルオキシ-3-ヒド ロキシー5-(2-テトラヒドロピラニルオキシカルボ ニル) アダマンタン (R'=H又はCH,、R'=OH、 $R^{t} = COOTHP, R^{t} = H$

【式(IIc)のモノマー単位】式(IIc)のモノマー単 位に対応するモノマーは、下記式(2c)で表される。 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。 [0035]

【化12】

【0036】(式中、R'は水素原子又はメチル基を示

す。R'及びR'0は、同一又は異なって、炭素数1~8 の炭化水素基を示し、R''、R''及びR'は、同一又は 異なって、水素素原子、メチル基又はヒドロキシル基を 示す。)

式(2c)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

[2-18] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1 ーメチルエチル) アダマンタン (R'=H又はCH,、R $^{1} = R^{10} = CH_{1}, R^{11} = R^{11} = R^{13} = H$

[2-19] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1 -エチルプロピル) アダマンタン (R'=H又はCH、、 $R^{1} = R^{10} = CH_{1}CH_{2}, R^{11} = R^{13} = H$ 1 - (1 - (メタ)アクリロイルオキシー 1 -メチルプロピル) アダマンタン (R'=H又はCH₃、 $R^{9} = CH_{3}, R^{10} = CH_{3}CH_{3}, R^{11} = R^{13} = R^{13}$ H)

[2-21] 1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー 1, 2-ジメチルプロピル) アダマンタン (R'=H又 BCH_{1} , $R^{9} = CH_{1}$, $R^{10} = CH_{1}$ (CH₁), $R^{11} =$ 20 $R^{13} = R^{13} = H$

[2-22] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1 ーメチルエチル) -3,5-ジメチルアダマンタン(R 1 = H X 1 C H₃, R^{9} = R^{10} = C H₃, R^{11} = R^{12} = C H $R^{13} = H$

[2-23] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1 -エチルプロピル) -3,5-ジメチルアダマンタン $(R^{1} = HX \& CH_{3}, R^{9} = R^{10} = CH_{1}CH_{3}, R^{11} =$ $R^{13} = CH_{3}, R^{13} = H$

[2-24] 1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー1 $(R^1 = HX \& CH_3, R^9 = CH_3, R^{10} = CH_1CH_3,$ $R^{11} = R^{12} = CH_3, R^{13} = H$

[2-25] 1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー 1,2-ジメチルプロピル)-3,5-ジメチルアダマ ンタン $(R' = H X は C H_3, R' = C H_3, R'' = C H_3)$ $(CH_1)_1, R^{11} = R^{12} = CH_1, R^{13} = H$

[2-26] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1 -メチルエチル) -3-ヒドロキシアダマンタン (R' $=HXLCH_3$, $R^3=R^{10}=CH_3$, $R^{11}=OH$, R^{13} $40 = R^{13} = H$

[2-27] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1 -エチルプロピル) -3-ヒドロキシアダマンタン (R 1 =HX 1 CH, 1 R 1 =CH, 1 CH, 1 R 1 =O H, R'' = R'' = H

[2-28]1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー1 -メチルプロピル) -3-ヒドロキシアダマンタン (R 1 = H \times ld C H₃, R^{9} = C H₃, R^{10} = C H₃ C H₃, R^{11} $=OH, R^{11}=R^{13}=H$

[2-29] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー 50 1, 2-ジメチルプロピル) -3-ヒドロキシアダマン

タン (R'=H又はCH₃、R'=CH₃、R'0=CH (C H_1), $R^{11} = OH$, $R^{12} = R^{13} = H$)

[式 (IId) のモノマー単位]

式(IId)のモノマー単位に対応するモノマーは、下記 式(2d)で表される。なお、これらのモノマーにおい て異性体が存在する場合には、それらは単独で又は混合 物として使用できる。

[0037]

【化13】

【0038】 (式中、R は水素原子又はメチル基を示 す。R''はメチル基又はエチル基を示し、R''、R''及 びR''は、同一又は異なって、水素原子、メチル基又は ヒドロキシル基を示す。)

化合物が挙げられる。

[2-30] 2-(メタ)アクリロイルオキシー2-メチ ルアダマンタン $(R^1 = H X d C H_3, R^{14} = C H_3$ $^{16} = R^{16} = R^{17} = H$

[2-31] 2-(メタ) アクリロイルオキシ-2-エチ ルアダマンタン $(R^1 = H X d C H_1, R^{14} = C H_1 C)$ H_1 , $R^{16} = R^{16} = R^{17} = H$)

[2-32] $2-(\times 9)$ POUDTWT+9-2, 3,5-トリメチルアダマンタン (R'=H又はCH,、R' $=CH_3$, $R^{16}=R^{16}=CH_3$, $R^{17}=H$)

[2-33]2-(メタ)アクリロイルオキシ-2-エチ ルー3, 5-ジメチルアダマンタン (R'=H又はC H_3 , $R^{14} = CH_1 CH_3$, $R^{15} = R^{15} = CH_3$, $R^{17} =$ H)

2- (メタ) アクリロイルオキシー2-メチ [2-34]ルー3-ヒドロキシアダマンタン (R'=H又はCH,、 $R^{14} = C H_3$, $R^{15} = R^{16} = H$, $R^{17} = C H_3$)

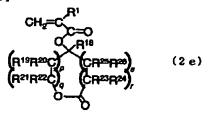
2-(メタ)アクリロイルオキシ-2-メチ ルー5-ヒドロキシアダマンタン (R'=H又はCH,、 $R^{14} = CH_3$, $R^{16} = CH_3$, $R^{16} = R^{17} = H$)

2-(メタ)アクリロイルオキシー2-エチ ルー3-ヒドロキシアダマンタン (R'=H又はCH,、 $R^{14} = CH_1CH_3$, $R^{16} = R^{16} = H$, $R^{17} = CH_3$)

2-(メタ)アクリロイルオキシ-2-エチ ルー5-ヒドロキシアダマンタン $(R^1 = H 又は CH_1)$ $R^{14} = CH_1 CH_3$, $R^{15} = CH_3$, $R^{15} = R^{17} = H$)

[式(IIe)のモノマー単位]式(IIe)のモノマー単 位に対応するモノマーは、下記式(2e)で表される。 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。

[0039] (化14)



【0040】(式中、R1は水素原子又はメチル基を示 及びR¹¹は、同一又は異なって、水素原子又はメチル基 を示す。p、q、r及びsはそれぞれ0又は1を示 す。)

式(2e)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

[2-38] α - (メタ) アクリロイルオキシー γ - プチ ロラクトン $(R' = H X d C H_1, R'' = R'' = R'' = R'' = R''$ $r = R^{11} = H, p = q = 1, r = s = 0$

[2-39] α-(メタ) アクリロイルオキシ-α-メチ 式(2 d)で表される化合物の代表的な例として下記の 20 ルーィープチロラクトン (R'=H又は CH_{3} 、 $R'^{3}=C$ H_{1} , $R^{19} = R^{10} = R^{11} = R^{11} = H$, p = q = 1, r = qs = 0)

> [2-40] ジメチルー γ ープチロラクトン (R' = H又はCH, R $R^{11} = R^{10} = CH_1, R^{11} = R^{11} = R^{11} = H_1, p = q = q$ 1, r = s = 0)

[2-41] α - (メタ) アクリロイルオキシー α , β , β ートリメチルー γ ープチロラクトン($R^i = H又は<math>C$ H_1 , $R^{18} = R^{19} = R^{19} = CH_1$, $R^{11} = R^{11} = H$, p 30 = q = 1, r = s = 0

[2-42] α - (メタ) アクリロイルオキシー γ , γ -ジメチルーァープチロラクトン(R'=H又はCH,、R $^{11} = R^{11} = CH_1$, $R^{11} = R^{11} = R^{10} = H$, p = q =1, r = s = 0)

ィージメチルーィープチロラクトン(R' =H又はC H_1 , $R^{11} = R^{11} = R^{11} = CH_1$, $R^{11} = R^{10} = H$, p =q = 1, r = s = 0

[2-44] β-(メタ) アクリロイルオキシーィープチ 40 ロラクトン $(R^1 = H X は C H_1, R^{18} = R^{18} = R^{18} = R$ $^{13} = R^{14} = H$, p = r = 1, q = s = 0)

[2-45] β-(メタ) アクリロイルオキシーβ-メチ ルー γ -プチロラクトン (R^1 =H又は CH_3 、 $R^{18}=C$ H_3 , $R^{13} = R^{20} = R^{23} = R^{24} = H$, p = r = 1, q = r = 1s = 0)

[2-46]β-(メタ) アクリロイルオキシ-β-メチ $\mathcal{N} - \delta - \mathcal{N} \mathcal{V}$ ロラクトン (R'=H又はCH₃、R''=C H_3 , $R^{10} = R^{20} = R^{21} = R^{21} = R^{13} = R^{14} = H$, p =q = r = 1, s = 0)

[式(IIf)のモノマー単位]式(IIf)のモノマー単 50

位に対応するモノマーは、下記式(2 f)で表される。 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。 [0041]

【化15】

【0042】(式中、R1は水素原子又はメチル基を示 す。R''は水素原子、置換基を有してもよい、炭素数1 ~20のアルキル基、環状アルキル基、有橋環状アルキ ル基、環状エーテル基又は環状エステル基を示す。 R¹¹ はR¹¹の置換基であり、水素原子、ヒドロキシル基、ヒ ドロキシメチル基、オキソ基、カルボキシル基又は-C OOR''を示し、R''は置換基を有してもよい、炭素数 1~20のアルキル基、環状アルキル基、有橋環状アル キル基、環状エーテル基、環状エステル基を示す。) 式(2f)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

[2-47](メタ) アクリル酸 (R'=H又はCH,、R $^{17} = H$)

[2-48](メタ) アクリル酸 メチル (R'=H又は CH_1 , $R^{17} = CH_1$)

[2-49](メタ) アクリル酸 エチル (R'=H又は CH_3 , $R^{17} = CH_1CH_3$)

[2-50] (メタ) アクリル酸 メトキシエチル (R' =H又はCH,、R¹⁷=メトキシエチル基)

[2-51](メタ) アクリル酸 n-プチル (R'=H 又はCH₁、R^{1†}=n-プチル基)

[2-52](メタ) アクリル酸 t - プチル (R' = H)又は CH_{3} 、 $R^{17} = t - プチル基$)

[2-53](メタ) アクリル酸 シクロヘキシル (R' =H又はCH,、R¹⁷=シクロヘキシル基)

[2-54](メタ) アクリル酸 ノルボルニル (R'= H又はCH₁、R¹⁷=ノルボルニル基)

[2-55](メタ) アクリル酸 イソボルニル (R'= H又はCH₃、R¹7=イソポルニル基)

(メタ) アクリル酸 2-テトラヒドロピラ ニル基)

[2-57](メタ) アクリル酸 2-テトラヒドロフラ ニル $(R^1 = H X d C H_3, R^{17} = 2 - テトラヒドロフラ$ ニル基)

[2-58] (メタ) アクリル酸 8-ヒドロキシメチルー 4-トリシクロ [5. 2. 1. 01.6] デカニル (R' =H又はCH₃、R¹⁷=トリシクロ [5. 2. 1.

0^{1.6}] デカニル基、 R¹⁷=ヒドロキシメチル基)

[2-59] (メタ) アクリル酸 4-トリシクロ [5.

2. 1. 0^{1.1}] デカニル (R¹=H又はCH₃、R¹¹= 50

トリシクロ [5.2.1.01.6] デカニル基) [2-60] (メタ) アクリル酸 8-トリシクロ [5. 2. 1. 0^{1.6}] デカニル (R'=H又はCH₁、R¹⁷= トリシクロ [5.2.1.01.6] デカニル基) [2-61] (メタ) アクリル酸 4-テトラシクロ [4. 4. 0. 1*. 1'. 1'. 1' ドデカニル (R'=H又はC H_{3} 、 R^{17} =テトラシクロ [4.4.0.1^{1.6}.

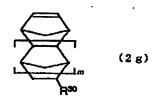
[式 (IIg) のモノマー単位] 式 (IIg) のモノマー単 10 位に対応するモノマーは、下記式 (2g) で表される。 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。

[0043]

1'.'0] ドデカニル基)

【化16】

20



【0044】 (式中、 R30は水素原子、ヒドロキシル 基、ヒドロキシメチル基、オキソ基、カルボキシル基又 は-COOR''を示し、R''は置換基を有してもよい、 **炭素数1~20のアルキル基、環状アルキル基、有橋環** 状アルキル基、環状エーテル基、環状エステル基を示 す。mは0又は1を示す。)

式(2g)で表される化合物の代表的な例として下記の 化合物が挙げられる。

[2-62] ノルボルネン (R³°=H、m=0)

[2-63] 5-ノルボルネン-2-オール (R³⁰=O 30 H, m=0

[2-64] 5- / ルポルネン- 2 - メタノール (R³⁰ = 1) $CH_1OH, m=0$)

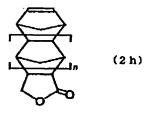
[2-65] 5- ルポルネン -2-カルポン酸 $(R^{1}) =$ COOH, m=0)

[2-66] 5-ノルボルネン-2-カルボン酸 t-プ チルエステル $(R^{17} = COOtBu, m = 0)$

[式(IIh) のモノマー単位] 式(IIh) のモノマー単 位に対応するモノマーは、下記式 (2 h) で表される。 ニル(R'=H又はCH,、R''=2-テトラヒドロピラ 40 なお、これらのモノマーにおいて異性体が存在する場合 には、それらは単独で又は混合物として使用できる。

[0045]

【化17】



【0046】 (式中、 nは0又は1を示す。) 式 (2

h) で表される化合物として下記の化合物が挙げられ る。

[2-67]4-オキサトリシクロ[5.2.1. $0^{1.1}$] $f_{D} = 8 - x - 3 - x - (n = 0)$

6-オキサペンタシクロ「9.2.1.1 '.'. 0'.''] ペンタデカン-12-エン-5-オン (n=1)

[式(IIi)のモノマー単位]式(IIi)のモノマー単 位に対応するモノマーは、下記式(2i)で表される。 [0047]

【化18】

【0048】式(2i)で表される化合物は下記の化合 物である。

[2-69]無水マレイン酸

本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、前記本発明の フォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤とを含んで

【0049】光酸発生剤としては、露光により効率よく 酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアソニ ウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへ キサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例 えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネ ートなど)、スルホン酸エステル[例えば、1-フェニ ルー1-(4-メチルフェニル)スルホニルオキシー1 ーペンゾイルメタン、1,2,3-トリスルホニルオキ 30 像により、所定のパターンを精度よく形成できる。 シメチルペンゼン、1,3-ジニトロ-2-(4-フェ ニルスルホニルオキシメチル) ペンゼン、1-フェニル -1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル) -1-ヒドロキシ-1-ベンゾイルメタンなど]、オキ サチアゾール誘導体、s-トリアジン誘導体、ジスルホ ン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合 物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノン、ベン ゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生 剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

【0050】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成 40 する酸の強度や前記高分子化合物における各モノマー単 位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記高分 子化合物100重量部に対して0.1~30重量部、好 ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重 量部程度の範囲から選択できる。

【0051】フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ 可溶性樹脂(例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹 脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など) などの アルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機 溶媒 (例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ア 50 ルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテ ル類、セロソルプ類、カルビトール類、グリコールエー テルエステル類、これらの混合溶媒など) などを含んで いてもよい。

【0052】このフォトレジスト用樹脂組成物を基材又 は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介し て、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さら に露光後ペークを行い) 潜像パターンを形成し、次いで 現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成 10 できる。

【0053】基材又は基板としては、シリコンウエハ、 金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げら れる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコ ータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布 手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば $0.~1\sim20\,\mu$ m、好ましくは $0.~3\sim2\,\mu$ m程度であ る。

【0054】露光には、種々の波長の光線、例えば、紫 外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通 常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeC 1、KrF、KrCl、ArF、ArClなど) などが 使用される。露光エネルギーは、例えば1~1000m J/cm¹、好ましくは10~500mJ/cm¹程度で ある。

【0055】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、 この酸により、例えば前記高分子化合物のアルカリ可溶 性ユニットのカルボキシル基等の保護基 (脱離性基) が 速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等 が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現

[0056]

【発明の効果】本発明にて合成できたモノマーを使用す ることにより、本発明でのフォトレジスト用高分子化合 物は、ラクトン環を含む特定構造の脂環多環式骨格を有 するモノマー単位により、高度なエッチング耐性が期待 されるうえに、基板に対する密着性、更にはモノマーに 特殊な構造を導入したことで、酸脱離性などの機能も付 加されている。また、他のモノマーと組み合わせること により、更にそれぞれの機能を向上させることも可能で ある。

【0057】本発明のフォトレジスト用樹脂組成物及び 半導体の製造方法によれば、レジストとして上記のよう な優れた特性を有する高分子化合物を用いるので、微細 なパターンを高い精度で形成することができる。

[0058]

【実施例】以下に実施例に基づいて本発明を詳細に説明 するが、本発明は実施例により限定されるものではな 41

合成例1

前記式(1a)においてR'、R'、R'がともにメチル

[グリニヤール還元工程]フラスコに、あらかじめ臭化メ し、 チルと金属マグネシウムとから調製した12重量%メチ り、 ルマグネシウムプロミドーテトラヒドロフラン溶液5 -> 9.6g(63mmol)を仕込んだ。この溶液に、内 1. 温を35℃以下に保持しつつ、1-アダマンタンカルボ 10 た。 ン酸n-ブチルエステル4.7g(20mmol)をテ トラヒドロフラン7.21gに溶かした溶液を滴下し 前語 た。滴下後、室温で1時間攪拌した。 、、、

【0059】10重量%硫酸水溶液32.37g中に、上で得られた反応混合液を、内温を35℃以下に保持しつつ滴下した後、5重量%水酸化ナトリウム水溶液で中和し、分液させた。水層をベンゼン20gで2回抽出した。有機層を合わせ、飽和食塩水20gで洗浄し、続いて無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。乾燥後、濾過し、濾液を減圧下で濃縮して、1-(1-ヒドロキシ-1-20メチルエチル)アダマンタンを得た。1-アダマンタンカルボン酸n-プチルエステル基準の収率は88.7%であった。

[酸化工程] 攪拌機、凝縮器及びガス流通管を備えたフラスコにクロロベンゼン/酢酸(重量比で50/50)の混合溶媒30mlを入れ、これに、1-(1-ヒドロキシー1-メチルエチル)アダマンタンを3.9g(20mmol)、N-ヒドロキシフタルイミド0.33g(2mmol)及び酸化パナジウムV₁O₁0.018g(0.1mmol)を加え溶解させ、酸素ガス流通下、85℃で5時間攪拌した。反応混合液をガスクロマトグラフィーにより分析した結果、目的物であるが1-(1-ヒドロキシー1-メチルエチル)-4-オキソアダマンタン0.33g(1.6mmol)が存在していた。収率としては8%であった。反応液はカラムクロマトグラフィーに付し、目的物を分離した。

【0060】[ラクトン化工程]滴下ロート、凝縮器及び 攪拌器を備えたフラスコに、1-(1-ヒドロキシ-1 -メチルエチル)-4-オキソアダマンタン2.1g (10mmo1)酢酸エチル20m1を加え、50℃に 40 て30wt%過酢酸の酢酸エチル3.0g(11.5m mo1)を滴下した。滴下後、更に5時間撹拌を続け た。反応した液をガスクロマトグラフィーにて分析した ところ、目的とした1-(1-ヒドロキシ-1-メチル エチル)-4-オキサトリシクロ[4.3.1. 13.1]ウンデカン-5-オンが1.7g(7.6mm o1)収率76%で生成していた。反応液はカラムクロ マトグラフィーに付して、目的物を分離した。 【0061】[エステル化工程]1-(1-ヒドロキシ-

1-メチルエチル)-4-オキサトリシクロ[4.3.

1. 1³·⁸] ウンデカン-5-オン2. 2g(10mm o 1)、トリエチルアミン20mmol及びテトラヒドロフラン40mlの混合液に、アクリル酸クロリド15mmolを約30分かけて滴下した。滴下終了後、室温で6時間攪拌した。反応混合液に水を添加した後、濃縮し、濃縮物をカラムクロマトグラフィーに付すことにより、目的物である1-(1-メタクリロイルオキシー1-メチルエチル)-4-オキサトリシクロ[4.3.1.1³·⁸] ウンデカン-5-オンを収率76%で得た

合成例2

前記式(1b)においてR'、R'がともにメチル基、R '、R'、R'がともに水素原子でX'、X'が-CH. -で Xbが-CO-O-である化合物2-メタクリロイルオ キシー2-メチルー6-オキサトリシクロ[4.3. 1. 13.6] ウンデカン-7-オンの合成例を示した。 [酸化工程] 攪拌機、凝縮器及びガス流通管を備えたフラ スコにクロロベンゼン/酢酸(重量比で50/50)の 混合溶媒30m1を入れ、これに、2-ヒドロキシー2 -メチルアダマンタンを3.3g(20mmol)、N -ヒドロキシフタルイミド 0.33g(2mmo1)及 び酸化パナジウムV₁O₁0.018g(0.1mmo 1)を加え溶解させ、酸素ガス流通下、85℃で3時間 **攪拌した。反応混合液をガスクロマトグラフィーにより** 分析した結果、目的物である2-ヒドロキシ-2-メチ ル-4-オキソアダマンタンが0.25g(1.4mm ol) が存在していた。収率としては7%であった。反 応液はカラムクロマトグラフィーに付し、目的物を分離 した。

【0062】[ラクトン化工程]滴下ロート、凝縮器及び 攪拌器を備えたフラスコに、2ーヒドロキシー2ーメチ ルー4ーオキソアダマンタン1.8g(10mmol) 酢酸エチル20mlを加え、50℃にて30wt%過酢 酸の酢酸エチル3.0g(11.5mmol)を滴下した。滴下後、更に5時間撹拌を続けた。反応した液をガ スクロマトグラフィーにて分析したところ、目的とした 2ーヒドロキシー2ーメチルー6ーオキサトリシクロ [4.3.1.1³・・*] ウンデカンー7ーオンが1.5 g(7.6mmol)収率76%で生成していた。反応 液はカラムクロマトグラフィーに付して、目的物を分離 した。

[エステル化工程] 2-ヒドロキシ-2-メチル-6-オキサトリシクロ [4.3.1.1**] ウンデカン-7-オン2.0g(10mmol)、トリエチルアミン20mmol及びテトラヒドロフラン40mlの混合液に、アクリル酸クロリド15mmolを約30分かけて滴下した。滴下終了後、室温で6時間攪拌した。反応混合液に水を添加した後、濃縮し、濃縮物をカラムクロマトグラフィーに付すことにより、目的物である2-メタクリロイルオキシ-2-メチル-6-オキサトリシクロ

[4.3.1.13.4] ウンデカン-7-オンを収率7 0%で得た。

【0063】 実施例1

下記構造の髙分子化合物の合成

[0064]

【化19】

【0065】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 5.00g、および開始剤(和光純菜工業製V-6 5) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶 解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、 反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間費 20 拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液 500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別することで精 製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒ ドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を操 り返すことにより、所望の樹脂4.24gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が6000、分子量分布が1.95であった。 'H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 ppm に強いシグナルが観測された。

【0066】 実施例2

下記構造の高分子化合物の合成

[0067]

【化20】

【0068】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 4. 41g、モノマー[2-5] (メタクリレー ト) 0.59g、および開始剤(和光純薬工業製V-6 5) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶 解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、 反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪 **拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液 50**

500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別することで精 製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒ ドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を繰 り返すことにより、所望の樹脂4.32gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が6200、分子量分布が2.05であった。 'H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1ppm、4. 6ppm に強いシグナルが観測された。

26

10 【0069】 実施例3 下記構造の高分子化合物の合成 [0070] 【化21】

【0071】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml 丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 4. 19g、モノマー [2-12] (メタクリレー ト) 0.81g、および開始剤(和光純薬工業製V-6 5) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶 解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、 反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間費 拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液 30 500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別することで精 製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒ ドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を繰 り返すことにより、所望の樹脂3.82gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が5500、分子量分布が1.87であった。 H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1ppm、4. 6ppm に強いシグナルが観測された。

【0072】 実施例4

40 下記構造の高分子化合物の合成

[0073]

【化22】

【0074】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 4.32g、モノマー[2-18] (メタクリレー ト) 0.68g、および開始剤(和光純薬工業製V-6 5) 1.00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶 解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、 反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪 拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液 500mlに落とし、生じた沈澱物を適別することで精 製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒ 10 ドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を繰 り返すことにより、所望の樹脂4.05gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が5700、分子量分布が1.92であった。 'H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1ppm、4. 6ppm に強いシグナルが観測された。

【0075】実施例5 下記構造の高分子化合物の合成

[0076] [化23]

【0077】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 30 m l 丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 4. 38g、モノマー [2-30] (メタクリレー ト) 0.62g、および開始剤(和光純薬工業製V-6 5) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶 解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、 反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪 拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液 500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別することで精 製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒ ドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を繰 り返すことにより、所望の樹脂4.10gを得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が5700、分子量分布が2.03であった。 H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1ppm、4. 6ppm に強いシグナルが観測された。

【0078】 実施例6

下記構造の高分子化合物の合成

[0079]

【化24】

[0080] 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 4. 36g、モノマー[2-56] (メタクリレー ト) 0.64g、および開始剤(和光純薬工業製V-6 5) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶 解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、 反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪 拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液 500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別することで精 製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒ ドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を繰 20 り返すことにより、所望の樹脂 4. 24 g を得た。回収 したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が6000、分子量分布が1.98であった。「H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1 ppm、3. 7 pp m、4.6ppm、5.7ppmに強いシグナルが観測 された。

【0081】実施例7 下記構造の高分子化合物の合成 【0082】

【化25】

【0083】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 40 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレート)3.06g、モノマー [2-26] (メタクリレート)1.94g、および開始剤(和光純薬工業製V-65)1.00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混合液500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別することで精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テトラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作を繰50 り返すことにより、所望の樹脂4.32gを得た。回収

したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分子量 が6200、分子量分布が2.03であった。 H-N MR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2.5p pm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 pp m、4.7ppmに強いシグナルが観測された。

【0084】実施例8

下記構造の高分子化合物の合成

[0085]

【化26】

【0086】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (アクリレー ト) 3.00g、モノマー[2-66] 1.33g、モ 20 ノマー [2-69] O. 67g、および開始剤(和光 純薬工業製V-601) 0.50gを入れ、酢酸n-プ チル5gに溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素 置換した後、反応系の温度を70℃に保ち、窒素雰囲気 下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンとイソプロパノ ールの1:1混合液200mlに落とし、生じた沈澱物 を遮別することで精製を行った。回収した沈澱を減圧乾 燥後、再度酢酸 n - プチル10g に溶解させ、上述の沈 澱精製操作を繰り返すことにより、所望の樹脂3.55 gを得た。回収したポリマーをGPC分析したところ、 重量平均分子量が9500、分子量分布が2.78であ った。 'H-NMR (DMSO-d6中) 分析では、

1. 5-2. 8ppm (プロード) のほか、3. 1pp m、3. 7ppm、4. 6ppm、5. 7ppmに強い シグナルが観測された。

【0087】 実施例9

下記構造の高分子化合物の合成

[0088]

【化27】

【0089】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 3. 51g、モノマー[2-6] (メタクリレー

ト) O. 61g、モノマー[2-7] (メタクリレー ト) 0.87g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1.00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500mlに落とし、生じた沈澱物を適別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 10 を繰り返すことにより、所望の樹脂4.10gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5600、分子量分布が1.95であった。'H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。

【0090】実施例10

下記構造の高分子化合物の合成

[0091]

【化28】

【0092】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 m l 丸底フラスコにモノマー [1 – 1] (メタクリレー ト)3.68g、モノマー[2-18] (メタクリレー ト) 0. 47g、モノマー[2-7] (メタクリレー ト) 0.85g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈澱物を濾別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 40 を繰り返すことにより、所望の樹脂4.22gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が6200、分子量分布が2.10であった。'H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3.1 ppm、4.6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。

【0093】実施例11

下記構造の高分子化合物の合成

[0094]

【化29】

【0095】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー 10 ト) 3. 49g、モノマー[2-30] (メタクリレー ト) 0. 64g、モノマー [2-7] (メタクリレー ト) 0.87g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1.00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈澱物を濾別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト を繰り返すことにより、所望の樹脂3.92gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5700、分子量分布が1.91であった。 'H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 p pm、4.7 ppmに強いシグナルが観測された。

【0096】実施例12

下記構造の高分子化合物の合成

[0097]

【化30】

【0098】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 m l 丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー 40 ト) 3.84g、モノマー[2-52] (メタクリレー ト) 0. 27g、モノマー [2-7] (メタクリレー ト) 0.89g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト

を繰り返すことにより、所望の樹脂4.05gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5600、分子量分布が1.88であった。 'H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。 【0099】 実施例13

下記構造の高分子化合物の合成

[0100]

【化31】

【0101】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 20 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 3. 51g、モノマー [2-5] (メタクリレー ト) 1. 02g、モノマー[2-8] (メタクリレー ト) 0. 47g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈澱物を濾別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト 30 ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 を繰り返すことにより、所望の樹脂4.11gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5900、分子量分布が2.08であった。「H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3.1 ppm、4.6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。

【0102】実施例14

下記構造の高分子化合物の合成

[0103]

【化32】

【0104】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー

. ト) 3. 62g、モノマー[2-18] (メタクリレー ト) 0. 93g、モノマー[2-8] (メタクリレー ト) 0.45g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500mlに落とし、生じた沈澱物を濾別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 10 を繰り返すことにより、所望の樹脂3.87gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5500、分子量分布が1.92であった。'H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。

下記構造の髙分子化合物の合成

【0105】実施例15

[0106] [化33]

【0107】還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー 30 ト) 3. 70g、モノマー [2-30] (メタクリレー ト) 0. 85g、モノマー [2-8] (メタクリレー ト) 0. 45g、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈澱物を濾別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 40 を繰り返すことにより、所望の樹脂3.94gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5900、分子量分布が1.99であった。 H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。 【0108】 実施例16

下記構造の高分子化合物の合成 【0109】 【化34】

【0110】 還流管、攪拌子、3方コックを備えた50 ml 丸底フラスコにモノマー [1-1] (メタクリレー ト) 4. 12g、モノマー[2-52] (メタクリレー ト) 0. 40g、モノマー[2-8] (メタクリレー ト) 0. 47g 、および開始剤(和光純薬工業製V-65) 1. 00gを入れ、テトラヒドロフラン20gに 溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 20 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500mlに落とし、生じた沈澱物を遮別すること で精製を行った。回収した沈澱を減圧乾燥後、再度テト ラヒドロフラン20gに溶解させ、上述の沈澱精製操作 を繰り返すことにより、所望の樹脂4.15gを得た。 回収したポリマーをGPC分析したところ、重量平均分 子量が5700、分子量分布が2.08であった。「H -NMR (DMSO-d6中) 分析では、1.5-2. 5 ppm (プロード) のほか、3. 1 ppm、4. 6 p pm、4.7ppmに強いシグナルが観測された。

【0111】試験例

実施例1~16で得られたポリマー100重量部とトリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート10重量部とを溶媒である1,2一プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートと混合し、ポリマー濃度17重量%のフォトレジスト用樹脂組成物を調製した。このフォトレジスト用樹脂組成物をシリコンウエハーにスピンコーティング法により塗布し、厚み1.0 μ mの感光層を形成した。ホットプレート上で温度100℃で150秒間プリベークした後、波長247nmのKrFエキシマレーザーを用い、マスクを介して、照射量30mJ/cm²で露光した後、100℃の温度で60秒間ポストベークした。次いで、0.3Mのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により60秒間現像し、純水でリンスしたところ、何れの場合も、0.30 μ mのライン・アンド・スペースパターンが得られた。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ' 識別記号 F I デーマコート' (参考) C 0 8 L 35/00 C 0 8 L 35/00 45/00 45/00 G 0 3 F 7/039 6 0 1

F 夕一ム(参考) 2H025 AA02 AA08 AA14 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB08 CB10 CB14 CB41 CB45 CB52 FA17 4J002 BG071 BH021 BK001 EB116 EE056 EQ016 EU186 EV216 EV246 EV296 EV326 FD206 GP03 4J100 AK32R AL08P AL08Q AL08R AR11Q BA03Q BA03R BA11P BA20Q BC09Q BC09R BC53P

CA04 CA05 JA38